

PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR

ZTX789A

ISSUE 2 – APRIL 94

FEATURES

- * 25 Volt V_{CE0}
- * Gain of 200 at $I_C=2$ Amps
- * Very low saturation voltage

APPLICATIONS

- * Darlington replacement
- * Battery powered circuits
- * Motor drivers



**E-Line
TO92 Compatible**

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-25	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-25	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	-8	A
Continuous Collector Current	I_C	-3	A
Practical Power Dissipation*	P_{totp}	1.5	W
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$ derate above 25°C	P_{tot}	1 5.7	W mW/ $^\circ\text{C}$
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +200	$^\circ\text{C}$

*The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a P.C.B. with copper equal to 1 inch square minimum

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-25			V	$I_C=-100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-25			V	$I_C=-10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5			V	$I_E=-100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			-0.1	μA	$V_{CB}=-15\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			-0.1	μA	$V_{EB}=-4\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			-0.25 -0.45 -0.5	V	$I_C=1\text{A}, I_B=10\text{mA}^*$ $I_C=2\text{A}, I_B=20\text{mA}^*$ $I_C=3\text{A}, I_B=100\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			-1.0	V	$I_C=1\text{A}, I_B=10\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-0.8		V	$I_C=-1\text{A}, V_{CE}=-2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	300 250 200 100		800		$I_C=10\text{mA}, V_{CE}=-2\text{V}$ $I_C=1\text{A}, V_{CE}=-2\text{V}^*$ $I_C=2\text{A}, V_{CE}=-2\text{V}^*$ $I_C=6\text{A}, V_{CE}=-2\text{V}^*$

ZTX789A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$)

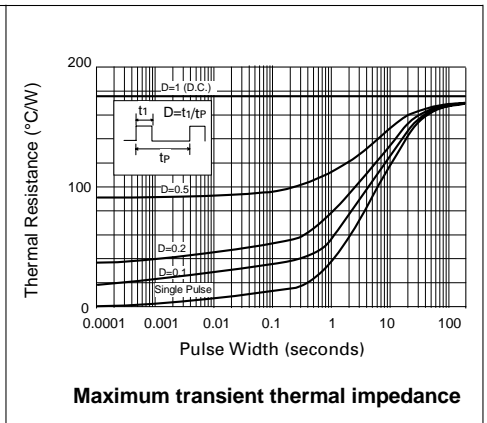
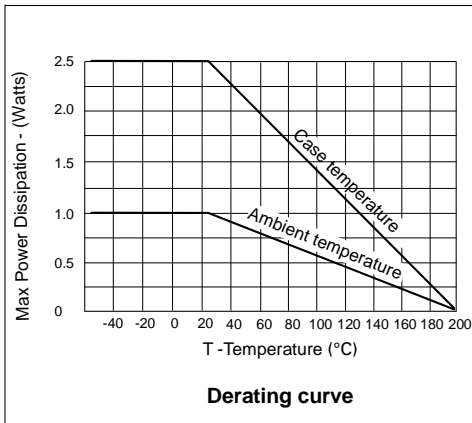
PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Transition Frequency	f_T	100			MHz	$I_C = -50\text{mA}$, $V_{CE} = -5\text{V}$ $f = 50\text{MHz}$
Input Capacitance	C_{ibo}		225		pF	$V_{EB} = -0.5\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}		25		pF	$V_{CB} = -10\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$
Switching Times	t_{on} t_{off}		35 400		ns ns	$I_C = -500\text{mA}$, $I_{B1} = -50\text{mA}$ $I_{B2} = -50\text{mA}$, $V_{CC} = -10\text{V}$

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

THERMAL CHARACTERISTICS

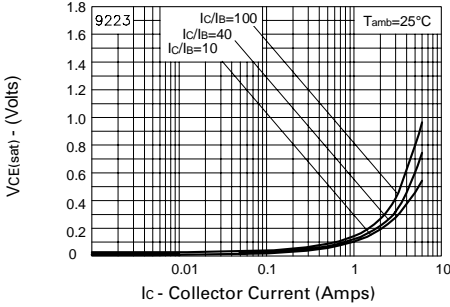
PARAMETER	SYMBOL	MAX.	UNIT
Thermal Resistance: Junction to Ambient ₁	$R_{th(j-amb)1}$	175	$^{\circ}\text{C/W}$
Junction to Ambient ₂	$R_{th(j-amb)2} \dagger$	116	$^{\circ}\text{C/W}$
Junction to Case	$R_{th(j-case)}$	70	$^{\circ}\text{C/W}$

\dagger Device mounted on P.C.B. with copper equal to 1 sq. Inch minimum.

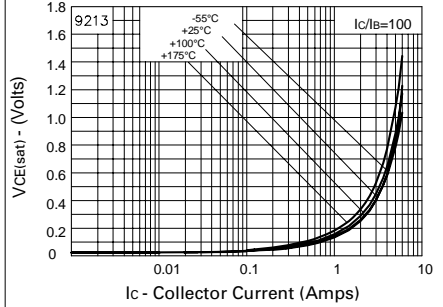


ZTX789A

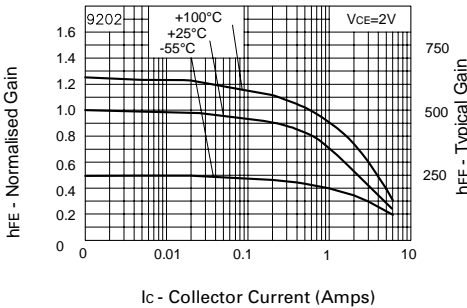
TYPICAL CHARACTERISTICS



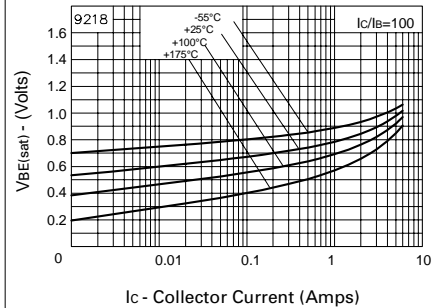
$V_{CE(sat)}$ v I_C



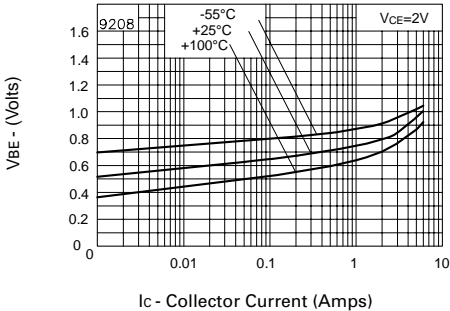
$V_{CE(sat)}$ v I_C



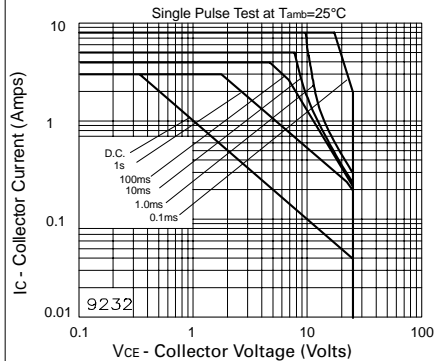
hFE v I_C



$V_{BE(sat)}$ v I_C



$V_{BE(on)}$ v I_C



Safe Operating Area

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9